**JAX**A

宇宙航空研究開発機構研究開発報告

XXA

# 宇宙航空研究開発機構研究開発報告 JAXA Research and Development Report

半導体レーザ吸収法によるExpansion Tube気流の計測

中北 和之, Jay B. JEFFRIES, Ronald K. HANSON

JAXA-RR-07-045



2008年2月



Japan Aerospace Exploration Agency

### ISSN 1349-1113 JAXA-RR-07-045

日次
----

概要		1
1 はし	ごめに	2
2 St	anford 6 inch Expansion Tube	2
2.1	Expansion tube の概要	2
2.2	Stanford 6 inch Expansion Tube 気流への半導体レーザ吸収法適用	3
3 半導	算体レーザ吸収法	3
3.1	原理	3
3.2	気体水分子を用いる吸収法	5
3.3	半導体レーザ吸収法のデータ処理	5
3.4	Line Selection (最適吸収線の選定)	6
3.5	温度計測手法	7
3.6	半導体レーザスキャン周波数	8
3.7	計測用ハードウェア	9
4 試題	\$気体持続時間同定試験	9
4.1	使用吸収線	9
4.2	計測用模型及び試験セットアップ	9
4.3	試験気体持続時間計測結果	10
5 温月	ま計測試験	11
5.1	使用吸収線	11
5.2	計測用模型及びセットアップ	12
5.3	静的温度検証(初期計測結果)	12
5.4	計測ソフトの改良	13
5.5	静的温度検証(ソフト改良後の結果)	13
5.6	Expansion Tube 試験	14
	5.6.1 膨張波管気体が He の場合	14
	5.6.2 膨張波管気体が空気の場合	15
まとめ	)	16
Appen	dix 高温場計測システムの検討	18
A-1.	使用吸収線の選定、計測ソフトの改修	18
A-2.	溶鉱炉を用いた高温場での吸収線計測	19

## 半導体レーザ吸収法による Expansion Tube 気流の計測<sup>\*</sup>

中北 和之\*1、Jay B. JEFFRIES\*2、Ronald K. HANSON\*2

## Expansion Tube Flow Diagnostics Using Laser Diode Absorption Spectroscopy\*

## Kazuyuki NAKAKITA<sup>\*1</sup>, Jay B. JEFFRIES<sup>\*2</sup>, Ronald K. HANSON<sup>\*2</sup>

### Abstract

An expansion tube flow diagnostics was conducted to identify its flow static temperature as a research topic of the visiting researcher from JAXA. The expansion tube has constructed at High Temperature Gasdynamics Laboratory (HTGL), Department of Mechanical Engineering, Stanford University since July, 2005. As the expansion tube flow diagnostics, it was necessary to measure flow static temperature, however, it could not apply the conventional thermo sensors, which have poor time response, or theoretical estimation using incident Mach number of shock wave, which may cause error. The tunable laser diode absorption spectroscopy was applied because of its merits of fast and direct temperature measurement.

The target seed of the tunable laser diode absorption spectroscopy was water vapor. This article includes followings as the description of the measurement system preparation and construction;

- theory of absorption spectroscopy and temperature calculation

- line selection program to select best lines for the expansion tube tests
- test model for expansion tube test
- measurement system of the tunable laser diode absorption spectroscopy for expansion tube

HITRAN2004 was utilized to apply line selection and construct the data reduction software as the database of the absorption line.

The expansion tube flow diagnostics was conducted using the constructed measurement system. Its scanning frequency was 50kHz, measuring temperature every 20µs. The data acquisition rate was 50MHz ; 1000 data points on every one scan of absorption spectroscopy. At first, test gas duration was measured using single line setup. Then, the system was extended to two line setup and applied the static temperature measurement of the expansion tube flow.

Keywords : Absorption Spectroscopy, Temperature Measurement, Expansion Tube

### 概 要

2005 年 3 月からの1年間、長期在外研究員として滞在した Stanford 大学機械工学科(Department of Mechanical Engineering)高温気体力学研究室(High Temperature Gasdynamics Laboratory; HTGL)において、2005 年 7 月に完成した ばかりの Stanford 6 inch Expansion Tube 気流の静温計測のための研究を行った。expansion tube の気流持続時間は数 10µs ~数 ms と非常に短く、通常の温度センサによる温度計測は時間応答性の面から不可能であり、衝撃波速度を介した推定も誤差が大きい。このため高速の直接温度計測が可能な半導体レーザ吸収法を用いて気流静温の計測を行った。

半導体レーザ吸収法の対象計測種としては気体水分子を用いた。吸収法の原理と温度算出手法、多数の水分子吸収 線から試験条件に最適なラインを選択する最適吸収線選定プログラムの構築、吸収量及び温度計測のデータ処理ソフ トの作成、expansion tube での計測用模型及び計測システムの製作の概要を紹介する。吸収線選定及びデータ処理にあ たっての吸収線データベースとしては HITRAN2004 を活用した。

構築したシステムを用いて expansion tube 気流の計測を行った。半導体レーザ吸収法のスキャン周波数は expansion tube 気流の持続時間を考慮し 50kHz(20μs 毎に1点の温度を算出)とし、吸収量データの取り込みは 50MHz、1スキャンあた り 1000 点のデータを使った。まず吸収線1本のシステムでシステムの動作確認も含めた expansion tube の試験時間の同定 試験を行い、次に2本の吸収線を同時に計測するようシステムを拡張し、expansion tube 気流の静温の時間履歴を計測した。

<sup>\*</sup> 平成 19 年 12 月 3 日 受付 (Received 3 December, 2007)

<sup>\*1</sup> 総合技術研究本部 風洞技術開発センター (Wind Tunnel Technology center, Institute of Aerospace Technology)

<sup>\*2</sup> スタンフォード大学 機械工学科 高温気体力学研究室(High Temperature Gasdynamics Laboratory (HTGL), Department of Mechanical Engineering, Stanford University)

#### 1. はじめに

半導体レーザ吸収法は入力電流によって高速に出力波 長をスキャン可能な半導体レーザ(Laser Diode; LD)の特 徴を活かし、分子の吸収線形状を計測することを通して 種々の状態量を算出することができる分光計測法である。 温度、密度、速度などが計測でき[1-4]、主に燃焼計測の 分野での先端的計測として用いられている。高速・短時 間計測が可能、非接触計測であること、熱電対などの温 度センサが使えないような高温場への適用も可能といっ た利点がある。近年の通信や CD, DVD などの技術の発 展に伴い半導体レーザも急速な進歩を見せているが、こ れらも適用波長範囲の拡大、高速化などの面で半導体レ ーザ吸収法に大きく寄与している。

半導体レーザ吸収法は光路上の状態量の積分として しかデータが得られないとの問題点があり、流体計測の 分野での適用例は限られているが、その時間応答性と非 接触性、高温場への適用性によって燃焼計測の世界では 燃焼場の計測や実時間制御に用いられつつある。これま での研究例としては温度や計測対象種の密度計測の他に、 エンジンナセルに流入する空気の質量流量を実時間で計 測する試み[5]、Pulse Detonation Engineの計測[6]などが 行われている。空力計測や風洞への適用も試みられてい る[7-10]。また近年では Stanford 大と日産自動車の間で自 動車エンジン内のサイクルを通しての温度履歴の計測 [11]も行われている。計測対象種としては、燃焼計測の 分野で発達してきた技術であることから、気体水分子、 CO<sub>2</sub>、NO、O<sub>2</sub>など燃焼場で重要な役割を果たす種の利用 例が多く、前出の通信や CD, DVD 用の半導体レーザの 波長帯を活用できるバンドが主流である。

この半導体レーザ吸収法を expansion tube 気流の診断 ツールとして用いる。expansion tube は衝撃波管に類似の 短時間風洞であり、超高エンタルピ発生装置としても注 目されている[12]ものである。Stanford 大では設定圧力の 組み合わせを選ぶことでノズルを換えたりすることもな く広いシミュレーション範囲の気流を発生させる点に注 目し、航空機や飛翔体などの試験装置としての用途から SCRAM Jet エンジン内の着火過程の研究に用いる高温場 の生成まで、様々な試験条件での利用を目指している。 expansion tube の持続時間は非常に短く、エンジン燃焼を 模擬する高温流れ場のシミュレーションでは 100-200µs 程度となる場合もある。このような時間スケールでは熱 伝導を伴う通常の温度センサを用いることはできず、衝 撃波速度の計測と理論を組み合わせた流れ場の推定が用 いられることが一般的である。しかし、境界層の発達や 理論上は時間0での破膜を仮定するダイアフラムの存在 などの問題点も多い。このため直接計測が求められるが、 その際には非接触かつ光学計測である半導体レーザ吸収

法が有効なツールとなる。

本稿では完成直後の Stanford 6 inch Expansion Tube[13] の気流特性試験として test gas 時間の把握と気流静温の 計測を目的とし、50kHz での半導体レーザ吸収法計測が 可能であるシステムの選定、構築、気流評価用模型の製 作や、システムの改良、既知環境での性能評価などを経 て、実際の expansion tube への適用までを紹介する。

## 2. Stanford 6 inch Expansion Tube

#### 2.1 Expansion Tube の概要

expansion tube は衝撃波管に類似の短時間風洞であり、 衝撃波管の管端にさらに膨張波管を付加した構造を持つ。 メリットとしては建設費、運用経費が安価であること、 高圧管、低圧管、膨張波管のガス種や初期設定圧力を変 えることにより広い範囲のマッハ数や動圧、静温をもつ 気流を作り出せること、衝撃波管を上回る高エンタルピ 気流を発生可能なことなどがある。デメリットとしては 気流持続時間が短く、特に燃焼性ガスが自発火するよう な高い静温を持つケースでは1ms以下の試験時間しか確 保できないこと、低圧管と膨張波管の間の第2隔膜の存 在が試験気体に影響し、乱れや膜による気流汚染が起き ることなどがある。

Stanford 大では超音速流れや SCRAM Jet 内部の燃焼場 をシミュレートするための装置として Stanford 6 inch Expansion Tube を建設し、2005 年 7 月に完成した。図 1 にその外観を。図 2 に x-t ダイアグラムと構造を示す。 膨張波管の出口径は 4142mm である。各部はいくつかの 管をつなぎ合わせた構造となっており、発生させる気流 応じて各部の長さを最適化することが可能である。膨張 波管と計測部も兼ねる真空タンクの間には隔膜はなく、 初期設定圧力は同じとなる。



☑ 1 Stanford 6 inch Expansion Tube



図 2 Stanford 6 inch Expansion Tube の x-t ダイアグラムと構造

# 2.2 Stanford 6 inch Expansion Tube 気流への 半導体レーザ吸収法適用

expansion tube のような短時間風洞では温度を計測す ることは非常に難しい。直接に温度を計測することは熱 電対などの温度センサの応答性の限界からほぼ不可能で あり、一般には入射衝撃波マッハ数の計測値から衝撃波 関係式を用いて気流の静温を算出する方法が用いられる。 しかしこの方法も入射衝撃波が一度通過した後の試験気 体を他の波が通過して状態量が変化したり、管内に発達 する境界層の影響で入射衝撃波が徐々に減速したりする ような場合の推定温度は実際の気流温度に対して誤差を 持つこととなる。

このような問題を抱える一般的な手法に代わり半導体レーザを用いた光学的温度計測法により直接流れの温度を計測する。

Stanford 6 inch Expansion Tube がシミュレーションす る流れ場としては主に以下の2つの条件がある;

①飛行試験用条件

高度 2,500-200,000ft の飛行試験に相当する気流を シミュレート

Ps~ 0.02-90kPa, Ts~ 220-280K

②燃焼試験用条件

SCRAM Jet 内部の圧縮され高温となった流れ場を シミュレート

Ps~ 20-50 kPa, Ts~ 1000-1500K

この中の①飛行試験用条件に対し、試験気体の持続時間 計測と静温測定を行なう。

半導体レーザ吸収法を用いれば静温計測以外にもド ップラーシフトを用いた流速計測や、密度計測と速度計 測を組み合わせて得られる質量流量計測、運動量流量計 測、さらにはテストセクションで実際に燃料を燃焼させ た場の中での局所計測などにも計測対象を拡張すること が可能である。

#### 3. 半導体レーザ吸収法

#### 3.1 原理

吸収法とはある波長の光を媒質に入力し、媒質を通過 した光の一部が媒質により吸収された場合、その吸収量 から媒質の状態を算出する手法である。

半導体レーザはその特性として、活性層の温度により 発振波長が変化する。このため半導体レーザ吸収法では LD の出力波長を安定させるため LD は温度コントロー ラで温度を制御しながら用いられる。この特性を逆に利 用すると、温度を変化させることにより数 10cm<sup>-1</sup>の範囲 で波長を選択することができる。また LD に入力する電 流値を変化させると光出力が変化するとともに活性層の 温度も変化するため発振波長も変化する。この波長変化 は電流スキャン周波数にもよるが、1~数 cm<sup>-1</sup>のオーダ ーである。

この電流スキャンによる波長スキャンを行い、その際 の吸収量を計測すると波長に対する吸収量の変化を連続 的にモニタすることができ、吸収線形状や一連の吸収線 分布が計測できることになる。これが半導体レーザ吸収 法である。

図 3 に示される gas に入射する前後のレーザ光強度を それぞれ *I*<sub>0</sub>, *I* とすると、両者の関係は Beer-Lambert の式;



によって記述することができる。ここで  $k_{\nu}$ は spectral absorption coefficient であり;

$$k_{\nu} = P x_i S(T) \phi(\nu) \tag{2}$$

と表される。S(T)は temperature-dependent line strength、 $x_i$ は計測対象種 i のモル分率、P は場の静圧である。 $\phi(v)$ は normalized lineshape function であり、すべての周波数 を積分すると1となるよう規格化される;

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\nu) \, d\nu = 1 \tag{3}$$

またabsorbance k,Lを周波数方向に積分するとintegrated

absorbance;

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} -\ln\left(\frac{I}{I_0}\right) d\nu = \int_{-\infty}^{+\infty} k_{\nu}L \, d\nu = Px_i S(T)L \tag{4}$$

を得る。

lineshape function としては Voigt function を用いた;

$$\phi(v) = \frac{2}{\Delta v_C} \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi}} V(a, w) \quad \text{V: Voigt function}$$
(5)

$$V(a,w) = \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\exp(-u^2)du}{a^2 + (w-u)^2}$$
(6)

ここで、

Voigt a parameter; 
$$a = \frac{\sqrt{\ln 2}\Delta v_C}{\Delta v_D}$$
 (7)

non-dimensional line position; 
$$w = \frac{2\sqrt{\ln 2}(v - v_0)}{\Delta v_D}$$
 (8)

Doppler width; 
$$\Delta v_D = 7.162 \times 10^{-7} v_0 \sqrt{\frac{T}{M}}$$
 (9)

Collisional width; 
$$\Delta v_C = P \sum_i \chi_i (2\gamma_i)$$
,  $2\gamma_i = 2\gamma_{i,T_0} \left(\frac{T_0}{T}\right)^n$ 
(10)

Voigt function の計算には Whiting の方法[14]による近似 計算を用いた;

$$\frac{I_{\lambda}}{I_{\lambda_{CL}}} = \left[1 - \frac{\Delta v_C}{\Delta v_V}\right] \cdot \exp\left[-2.772 \left(\frac{\lambda - \lambda_{CL}}{\Delta v_V}\right)^2\right] + \left[\frac{\Delta v_C}{\Delta v_V}\right] \frac{1}{1 + 4 \left(\frac{\lambda - \lambda_{CL}}{\Delta v_V}\right)^2} + 0.016 \left[1 - \frac{\Delta v_C}{\Delta v_V}\right] \left[\frac{\Delta v_C}{\Delta v_V}\right] \left[\exp\left[-0.4 \left(\frac{\lambda - \lambda_{CL}}{\Delta v_V}\right)^{2.25}\right] - \frac{10}{10 + \left(\frac{\lambda - \lambda_{CL}}{\Delta v_V}\right)^{2.25}} \right]$$
(11)

Voigt width: 
$$\Delta v_V = \frac{\Delta v_C}{2} + \sqrt{\left(\frac{\Delta v_C^2}{4} + \Delta v_D^2\right)}$$
 (12)

Intensity at line center:

$$I_{\lambda_{CL}} = \frac{I}{\Delta v_V \left[ 1.065 + 0.447 \left( \frac{\Delta v_C}{\Delta v_V} \right) + 0.058 \left( \frac{\Delta v_C}{\Delta v_V} \right)^2 \right]}$$
(13)

半導体レーザ吸収法の特徴としては、

- ・熱電対等では不可能な 10kHz 以上の周波数での温 度計測が可能
- ・光学的な非接触計測
- line-of-sight 計測

ことが挙げられる。3 点目の line-of-sight 計測とは半導体 レーザ吸収法はレーザ光が通過したすべての媒質の影響 が反映される計測であることを意味する。このため半導 体レーザ吸収法は特に CT 法のような空間分布再構成手 法を用いない限りレーザ光路上の空間分解能は得られな い。

計測可能状態量としては、

- 計測対象種の分圧
- ・温度
- ・速度(ドップラーシフトより)
- また、これらの複合として、
  - · 質量流量
  - ·運動量流量

も計測可能となる。

#### 3.2 気体水分子を用いる吸収法

本研究では気体水分子(水蒸気)を計測対象種とした。 図 4(a), (b)はその分布である。これらからも分かるよう に近赤外領域には非常に多くの水分子吸収線が存在する。 図 4(b)上部の枠囲みは実用化されている LD の材質であ る。ここでは図 4(b)中の矢印で示した 1.4µm バンドの吸 収線を計測対象とした。このバンドの吸収線は倍波や混 合波であるため 2µm 以上に分布する基本波よりも吸収 量が小さいが、この領域は石英光ファイバの伝送損失最 小の領域に相当し、通信用レーザの多くはこの領域を用 いているため安価かつ高性能な LD が容易に入手可能で あるというメリットを持つ。

水分子は流体的な観点からは;

・通常の空気中に普遍的に存在

・燃焼生成物でもあり燃焼場の計測で重要 光学計測の観点からは;

- ・吸収量が大きい
- ・通信用 LD が使用可能

・光ファイバを利用し簡単に光学系が構築可能 などの長所を持つため半導体レーザ吸収法の計測対象種 として最も多く利用されている種である。

- 半導体レーザでは、
  - ① 購入時の半導体レーザ波長帯の指定
  - ② 温度コントロールによる個別波長の設定
  - ③ 電流スキャンによる波長スキャン

の3段階の波長設定により測定対象種の個々の吸収線に 特化した吸収法計測が可能である。シングルモード半導 体レーザの線幅は非常に小さく、分光器での計測などで 問題となるスリット関数との convolution などの問題も 低温や低圧以外ではほとんど問題とならない。

#### 3.3 半導体レーザ吸収法のデータ処理

半導体レーザ吸収法のデータ処理概略を図5に示す。 ①は計測生データである(縦軸: Volt, 横軸: サンプリ ング番号)。半導体レーザに供給する電流を変化させると 出力と同時に発振波長も変化する。x=600 付近の凹みが 水分子による吸収である。



(b) 図 4 水分子の吸収線分布

v [cm<sup>-1</sup>]

(a) 1-8μm (b) 0.7-3μm
 (b)は横軸が波数であるため(a)とは軸が異なるている

②では x=200~400 及び 850~950 部分の吸収のない領 域を用いて吸収のある領域の本来のベースラインを推定 する。推定されたベースラインが緑のラインである。② での赤のラインが図 3 での *I、*緑のラインが *I*<sub>0</sub>に対応す る。

③では計測されたデータ I と②で推定されたベースラ イン  $I_0$  から(1)によって absorbance を求める。ここでの absorbance の x 軸はサンプリング番号であるので本来求 めるべき波数に対する吸収量に変換するため、④で x 軸 をサンプリング番号から波数に変換する。このためには 図6上部に示すように半導体レーザデータと同時に計測 されたエタロンデータ(黒線)を使用する。エタロンは 図7のような平行度の非常に高いガラスで、共振周波数 は平行平面間の長さによって決まる。図6に示したデー タは共振周波数 2GHz のエタロンによるデータであり、 ピーク間の周波数が 2GHz に相当する。これにより④で のデータは縦軸が absorbance、横軸が相対波数にとった 吸収線プロファイルに変換された。⑤でこの計測データ に(11)-(13)の Voigt 関数を fitting し最適 fitting を与える 4 つのパラメータが決定される。これら4つのパラメータ を用いて integrated absorbance も計算でき、この integrated absorbance が温度算出や試験時間計測で用いられる吸収 量データとなる。



図5 半導体レーザ吸収法のデータ処理概略



### 3.4 Line Selection (最適吸収線の選定)

図4に示されたように水分子の吸収線は無数と言って よいほど多くある。これら多数の吸収線から試験対象と なる場に適当な吸収線を選択する必要がある。このため には必要な selection rules を決め、それに則って吸収線を 選択していく line selection プログラムを構築しなければ ならない。水分子の吸収線データベースとしては HITRAN2004[15,16]を用い、line selection プログラム製作



図7 エタロンとその周辺光学系

に当たっては Xin Zhou の方法[17]を参考とした。

HITRAN2004 には 1.0-2.0μm だけでも 15907 本の吸収 線が収蔵されており、この中から選択を進めていく。 selection rule としては以下の6個を設定した;

- 市販の InGaAsP 系 DFB LD が使える波長である こと
- ② 吸収量が十分大きいこと
- ③ 他の吸収線とのオーバーラップが十分小さいこと

- ④ 測定部以外の大気中の水分子の影響を受けにくいこと
- ⑤ 十分な温度感度が得られること
- ⑥ 水分子以外の他ガスの吸収線とのオーバーラッ プが十分に小さいこと

⑤に関しては温度計測時に用いる2本の吸収線のペアとして評価する。

HITRAN2004 からのデータとこれら6個の selection rules を用いた line selection プログラムを MATLAB 上で 構築し、選定を進めた。Line selection プログラムでは数 本から10本程度の絞込みまでを行い、最終的な最適ライ ンの決定はこれらのデータを比べつつ自分の手で行う。

#### 3.5 温度計測手法

3.1 節での式(4)より integrated absorbance A が温度  $T \ge$  吸収媒体の長さ L、静圧 P、吸収種のモル分率  $x_i$ の関数 であることが示されている。ここで line strength S(T)を書き表すと;

$$S(T, v_0) = S(T_0, v_0) \frac{T_0}{T} \frac{Q(T_0)}{Q(T)} \frac{1 - \exp\left(-\frac{hcv_0}{kT}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{hcv_0}{kT_0}\right)} \exp\left(-\frac{hcE''}{k} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right)$$

ここで、T<sub>0</sub>=296K, h: プランク定数 k: ボルツマン定数 c: 光速

*ν*₀: 吸収線の中心周波数

E": lower state energy of the transition Q(T): 分配関数

lower state energy E"の異なる2本の吸収線に対し、 integrated absorbance を取り出しその比を取ると、計測光 路が同一であれば吸収媒体の長さL、静圧P、吸収種の モル分率 $x_i$ は等しいため、式(4)と(14)より;

$$\frac{A_{1}}{A_{2}} = \frac{S(T, v_{1})}{S(T, v_{2})} \\
= \frac{S(T_{0}, v_{1})}{S(T_{0}, v_{2})} \exp\left(-\frac{hc}{k}\left(E_{1}^{"} - E_{2}^{"}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{0}}\right)\right) \times \left(\frac{1 - \exp\left(-\frac{hc}{kT}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{hc}{kT}\right)}\right) \\
\left(\frac{1 - \exp\left(-\frac{hc}{kT}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{hc}{kT_{0}}\right)}\right) \left(\frac{1 - \exp\left(-\frac{hc}{kT}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{hc}{kT_{0}}\right)}\right)^{-1} \tag{15}$$

が導かれる。

計測温度 
$$T$$
 が  $T_0=296K$  に近い場合には、  
 $1-\exp\left(-\frac{hcv_0}{kT}\right)/1-\exp\left(-\frac{hcv_0}{kT_0}\right)\approx 1$ との近似を用いて;

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{S(T, \nu_1)}{S(T, \nu_2)} \approx \frac{S(T_0, \nu_1)}{S(T_0, \nu_2)} \exp\left(-\frac{hc}{k} \left(E_1^{"} - E_2^{"}\right) \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right)$$
(16)

との式を使うこともできる。

温度計測のための2本の吸収線の選定には計測温度範 囲内で図8に示すように吸収量増減の傾向が逆になって いるものを選ぶほど計測精度が良くなる。



図8 温度計測のための吸収線の選定

3.4 節の⑥のプロセスでは、まず計測対象の温度・圧 力範囲を決定し、温度計測で想定される標準偏差の値を 用いて最適ラインを選定する。標準偏差は以下の式(17) を用いて算出する。

### Peak ratio

(14)

$$R = \frac{\left(\alpha_{peak}\right)_{highE''}}{\left(\alpha_{peak}\right)_{lowE''}} = \frac{H}{L}$$

Uncertainty of R

$$\sigma_{R}^{2} \approx \sigma_{H}^{2} \left(\frac{\partial R}{\partial H}\right)^{2} + \sigma_{L}^{2} \left(\frac{\partial R}{\partial L}\right)^{2} + 2\sigma_{HL}^{2} \left(\frac{\partial R}{\partial H}\right) \left(\frac{\partial R}{\partial L}\right)$$
  

$$\sigma_{H}, \sigma_{L} : \text{peak signal } \mathcal{O} \land \tilde{\mathbf{m}} \mathbb{E} \stackrel{\text{def}}{=} \sigma_{H} = \sigma_{M} \& \mathcal{E} \oplus \mathbb{E}$$
  

$$\sigma_{M} : \text{measured noise floor, } \& \mathbb{E} \mathbb{E} \text{ bick } 0.2 \sim 0.5\%$$

partial derivatives は以下のように書き表される;

$$\frac{\partial R}{\partial H} = \frac{R}{H}, \quad \frac{\partial R}{\partial L} = -\frac{R}{L}$$

$$\sigma_R = \sigma_M \frac{1}{L} \sqrt{1 + \left(\frac{H}{L}\right)^2} = \sigma_M \frac{1}{L} \sqrt{1 + R^2}$$

Measured temperature uncertainty

$$\sigma_T = \frac{\sigma_R}{dR/dT} = \sigma_M \frac{1}{dR/dT} \frac{1}{\left(\alpha_{peak}\right)_{lowE''}} \sqrt{1 + R^2}$$
(17)

温度計測のための処理ソフトウェアは LabVIEW 上に 構築し、データ処理を行った。

### 3.6 半導体レーザスキャン周波数

expansion tube では気流エンタルピを高くする燃焼試 験用条件では試験時間が 100µs にまで小さくなる。この ような気流を計測するためには高い計測レートで計測す る必要がある。

しかし、半導体レーザの物性としてスキャン周波数と スキャン波長範囲の間には反比例の関係があり、スキャ ン周波数を大きくするとスキャン波長幅が小さくなる。 またデータ収集装置(Data Acquisition (DAQ) Unit)の収 集可能周波数にも制限があり、高すぎる計測レートを用 いると1スキャン中の計測点数が少なくなり、Voigt fittingの精度に悪影響を及ぼす。さらには光検出器の周 波数応答性にも制約がある。計測の面では光検出器の面 積が大きく、気流の擾乱による optical steering によって 多少の入射位置に変動があっても出力に影響を与えない ものが望ましいが、面積の大きな光検出器は一般的に応 答性が悪くなる。

図9に半導体レーザのスキャン周波数とスキャン幅の 関係を示す。図9(a)のスキャン周期とスキャン幅からス キャン周期を小さくするとスキャン幅が小さくなること が分かる。同じスキャン周期であってもノコギリ波 (sawtooth)より三角波(triangle),サイン波(sinusoidal)の方 がスキャン幅が大きくなるが、高いスキャン周期での三 角波・サイン波では往復での吸収線位置のヒステリシス が顕著になり処理が複雑になるためノコギリ波を採用す る。また個々の半導体レーザによるスキャン周波数とス キャン幅の関係は個体差が大きい。

ここでの研究では半導体レーザのスキャン周波数を 50kHzと設定し、20µs毎に1点の温度が算出される。デ ータ取得レート 50MHz、1スキャンあたり 1000点の計 測点を収集し、データ処理を行った。

データ収集装置としては最大 100MHz (2CH の場合)、 12bit A/D 分解能でのデータ収集が可能な Gage Applied Technologies 製 Gage Scope CompuScope 12100 を 4CH, 50MHz の設定で使用した。また光検出器としては 10MHz の応答性を持つ Thorlabs 製 PDA400 を用いた。



図9 半導体レーザのスキャン周波数とスキャン幅の関係

(a)スキャン周期とスキャン幅,(b)-(c) スキャン波形,(b)ノコギリ波(sawtooth),(c)三角波(triangle),(d)サイン波(sinusoidal),三角波・サイン波では往復で吸収線位置にヒステリシスは現れる。

#### 3.7 計測用ハードウェア

半導体レーザ吸収法に用いる主なハードウェアとして は以下のようなものである。

#### 半導体レーザ

NTT Electronics Corporation (NEL) 製 DFB (Distributed Feedback) LD

14p Butterfly 形状、光ファイバ pigtail 付、FC/APC コネ クタ

#### 半導体レーザ関係

半導体レーザ・ドライバ LDX-3620 ILX Lightwave 製 温度コントローラ LDT-5910B ILX Lightwave 製 半導体レーザ・マウント LDM-4984 ILX Lightwave 製 ファンクションジェネレータ DS345 Stanford Research System 製

#### レーザ受信系

光検出器 PDA400 Thorlabs 製

#### Data Acquisition (DAQ) Unit

Gage Scope CompuScope 12100 Gage Applied Technologies 製

#### <u>光ファイバ</u>

光ファイバ 9µm core, single mode, FC/APC connector ファイバ・スプリッタ

FUSED-12-www-9/125-50/50-xyz-3-0.5 OZ Optics 製

FUSED-12-www-9/125-10/90-xyz-3-0.5

(光ファイバ出力を減少させたり、分岐させたりする ために用いる)

ファイバ・コリメータ F230FC-C Thorlabs 製 (光ファイバ端からのレーザ光を集光させる)

その他

集光レンズ プリズム 微調機能付きレンズマウント 等

#### 4. 試験気体持続時間同定試験

本来の目的である expansion tube の静温計測に先立ち、 expansion tube の試験気体の持続時間計測を行った。 expansion tube に備え付けの圧力センサ(後述の図11の PCB(Ps))では膨張波管気体と試験気体である低圧管気 体との区別が行えないため、半導体レーザ吸収法を用い て試験気体の同定を行なった。半導体レーザ吸収法では 試験気体だけに空気力学的に無視できる程度の量の水分 子をシードすれば膨張波管気体と試験気体を認識できる。

#### 4.1 使用吸収線

まず line selection プログラムを用いて最適な吸収線の 選定を行った。expansion tube の運転モードとしては飛行 試験用条件が対象である。3.4 節での①~④の selection rule を用いて最適なラインを選定し、⑥の他の種との干 渉の有無を確認した。

④の"測定部以外の水分子の影響を受けにくいこと" に関しては計測対象気流が室温と同程度の温度であり、 かつ計測対象気流の静圧は大気圧以下であるため、選定 当初から計測部以外の水分子による吸収量の影響が懸念 された。この問題については計測部以外の光学系をビニ ール袋で覆い窒素パージする方法(nitrogen bag)で対応 した。5.4 節で後述するが、温度計測の場合にはこの nitrogen bag だけでは対処しきれず、ソフト的な対応も必 要となった。

図 10 に選定された吸収線を示す。中心波数  $v_0=7294.1$ cm<sup>-1</sup>( $\lambda_0=1370.97$ nm), lower state energy E"=23.79 のラインである。E"が相当に低いため図 10 で温度が大 きくなるにつれ吸収量が低下していることからも分かる ように低温で存在確率の多いラインであるが、200-300K の温度範囲内では最も吸収量の大きいラインのひとつで あり、7293.85cm<sup>-1</sup>付近に別の小さな吸収ラインが存在す るがそれ以外には他のラインとの重なりもなく、Voigt fit も適用しやすいラインである。



#### 4.2 計測用模型及び試験セットアップ

図 11 に試験時間計測試験のセットアップを示す。高圧 管気体, 膨張波管気体は He、試験機体である低圧管気 体は空気である。試験気体の空気は水分を含む室内空気 をそのまま用いた。膨張波管気体は He であるが、初期 圧力が大気圧より低く、かつわずかな漏れがあるため微 量の水分を含んだ空気が混入した。膨張波管側の動作は 膨張波管壁面に設置した PCB 圧力センサによってモニ タする。PCB 圧力センサは衝撃波速度計測用として PCB 132A35(共振周波数>1MHz、立ち上がり時間 <3µs)が 30.5cm 間隔で4点、静圧計測用として PCB 112A22(共 振周波数>250kHz、立ち上がり時間 <2µs)が1点設置さ れている。

図 12 は計測部に設置された試験模型である。模型は 2つの平板から成り、その平板上の(412.7mmの石英ガラ ス製光学窓を通してレーザ光を透過させる。2つの平板 の気流外側には、光ファイバから出たレーザ光を集光す る collimator からなる入射系と、レーザ光を集光するレ ンズ、レンズ微動装置、光検出器からなる集光系の各装 置が設置されている。半導体レーザ自体は計測部外の大 気圧環境下に置かれ、光ファイバを介して計測部内の模 型までレーザ光を伝送する。

試験模型内にはピトー圧を計測するためのピトープ ローブを設置した。このピトープローブは気体の比熱比 とマッハ数の違いによるピトー圧の変化から膨張波管気 体と試験気体の気体組成差を検出できることから試験気 体到着時間の検出のために用いる。

#### 4.3 試験気体持続時間計測結果

図 13 に試験時間計測試験の結果を示す。赤線が図 11 に記されたピトープローブによるピトー圧、青線が integrated absorbance である。PCB 圧力センサから算出さ れた衝撃波マッハ数(Ms) 4.7 から計算された気流静圧 (Ps)は 13kPa, 静温(Ts)は 230K である。

青線の integrated absorbance に着目して流れを解析す る。赤線の Ps データによると 5ms 付近で気流が到達し ているが、その時間以前の integrated absorbance は He 中 に水分を含んだ空気がリークしているため一定値の吸収 が存在する。5msから5.5ms付近までは衝撃波によって 圧縮・加熱された膨張波管気体である。圧力は初期状態 より大きくなるが温度も大きくなるため、図10に示され るように吸収量は小さくなる。5.5ms 以降の integrated absorbance の増大が水分子を含んだ試験気体の到達であ る。ほぼ 6~10ms 付近が試験時間に相当する。10ms 以 降は圧力が低下しつつも integrated absorbance が増大し ている。これは気流温度が低下し、図10にも示されるよ うに integrated absorbance が増大したものである。その後 13~15ms にわたって integrated absorbance が急減してい る。これが水分子を含んだ試験気体と高圧 He の高圧管 気体が混在している接触面の領域に相当すると考えられ る。15ms以降は高圧管気体の領域になる。

図14に高圧管気体の初期圧力(P4)と低圧管気体の初期圧 カ(P1)と膨張波管気体の初期圧力(P10)の比が等しい2つ の試験時間同定試験結果を示す。赤線のピトー圧の履歴 の最初の圧力ステップは衝撃波の入射による圧力上昇、



図 11 試験時間同定試験セットアップ レーザ光路長 101.6mm



図 12 計測部に装着された試験模型 (実際の試験時には膨張波管の管端をさらに模型先 端近傍まで接近させる)



2番目のピトー圧上昇は試験気体到着による比熱比と マッハ数変化によるものである。ピトー圧と integrated absorbance を比較すると、全てのケースについて integrated absorbance の立ち上がりとピトー圧の2番目の 立ち上がりの時間は一致しており、ピトープローブを用 いることで試験気体の到着点を計測することができると 言える。しかし試験気体の終点についてはピトー圧波形 と integrated absorbance の間には有意な対応は認められ ず、ピトー圧履歴からは試験気体の終点は計測できない。 始点・終点の双方を決定し試験時間を同定するためには ピトー圧計測ではなく、半導体レーザ吸収法が必要であ ることが分かる。



#### 5. 温度計測試験

### 5.1 使用吸収線

3.4 節で記述した line selection rule 0① $\sim$ ⑥を適用して expansion tube の飛行試験用条件で最適吸収線を選定し た。図 15(a), (b)に選定された吸収線を示す。(a)は lower state energy の高い側のラインであり中心波数

 $v_0$ =7368.4cm<sup>-1</sup> ( $\lambda_0$ =1357.1nm), lower state energy E"=447.25 のラインである。(b)は lower state energy の低い側のライ ンであり、4 章の試験時間同定試験で用いたものと同じ ラインである。図 15(c)はこの line pair に noise floor 0.2% を仮定して求めた推定温度計測精度である。E"=447.25 のラインは 200-300K の範囲で吸収量の変化は小さいが、 E"=23.79のラインでは温度が大きくなるにつれ急激に吸 収量が小さくなるため、高温側ほど温度計測誤差が大き くなっている。また、圧力が小さくなっても温度計測誤 差が大きくなっているが、これは(4)式からも分かるよう に圧力が大きくなれば integrated absorbance が大きくな り計測精度が向上するためである。



H<sub>2</sub>O 分圧 1%, レーザ光路長 76.2mm (a) High E" Line, E"=447.25, (b) Low E" Line, E"=23.79 (c) 推定温度計測誤差, noise floor=0.2%仮定

This document is provided by JAXA.

#### 5.2 計測用模型及びセットアップ

図 16 に温度計測用模型の風洞への設置状況を、図 17 に光学系の構成と expansion tube に対す設置位置関係を 示す。試験時間同定試験ではレーザ光路1本、2枚の両 側壁のみであったが、温度計測用模型では温度計測のた めにレーザ光路を2本とし、2つの光路が極力同じ場を 計測できるように X 型の配置とした。風洞計測部に十分 な大きさがないため、レーザ光入射側の光学部品配置に も配慮した。

また試験時間同定試験では水分子を含む試験気体の検 出だけが目的であったため両側板のみで上下方向から計 測部に入射する膨張波管端面の影響は無視したが、温度 計測ではレーザ光路上の場の一様性が温度計測精度に影 響するため、上下にも平板を追加して矩形断面とし、模 型先端を膨張波管端面よりも上流側に挿入し、平板間の 距離も横 76.2mm、縦 63.5mm として膨張波管の気流コア だけを抽出できるよう変更した。この模型の平板の先端 部分の楔の角度は 22.5°であり衝撃波が離脱するマッハ 数は約2である。これより小さなマッハ数の気流ではチ ャネル内の流れはチョークすることになる。

図 16 で模型上部に設置されている追加の平板は気流 による光ファイバの振動防止用カバーであり、模型支持 脚にもテープで光ファイバが固定されている。シングル モードファイバであっても光ファイバが振動すると偏向 が変化し、光学窓などの反射面で反射する際の反射率が 変化する。これによって計測されるデータは吸収と等価 な変動を被ることになるため、試験中に光ファイバが振 動したりすることのないように固定には注意する必要が ある。

#### 5.3 静的温度検証(初期計測結果)

構築した試験模型、光学系、データ処理ソフトなどか らなるシステムを expansion tube 試験に用いる前に既知



図16 計測部に設置された温度計測用模型

の温度場を用いた静的温度検証試験を行った。静的な場 としては試験模型を装着した expansion tube の計測部を 風洞試験で想定される圧力に近い 33kPa 付近まで減圧し、 十分な時間放置して温度が室温(Actual Temp.)に等しい と考えられる場を用いた。室温としては水銀温度計によ る値を採用した。

これらの計測結果を表1に示す。各ケースはそれぞれ 100 点の計測点を用いて算出した結果である。標準偏差 は図 15(c)の 300K、100kPa での値よりかなり小さいが、 これは風洞試験時の仮定である光路長 76.2mm に比べ、 静的温度試験では模型外側が真空ではなく、模型内部と 同じ気体で満たされているため光路長が大きくなってい ること、1%の水分圧を仮定した計算より実際の水分圧が 大きかったことなどによるものである。一方、室温との 差は最大10K と静定した場の計測としては非常に精度が 悪く、expansion tube で計測を行ううえで大きな問題と考 えられる。

この大きな温度差の原因について調査したところ、図 18 に示すように計測部内を非常に低い圧力に設定した 際、低い圧力に相当する幅の狭い成分(白線の fitting 結 果と形状が近い)の他にピーク値は小さいものの幅の広 い大気圧下の水分子の吸収線が重畳していることが観測 された。図18でも分かるように計測ソフトの fitting では 考慮されていない大気圧成分が存在するために Voigt fitting の結果に誤差が含まれ、これが表1の温度誤差を もたらしたものと考えられる。

表1 静的温度検証結果(初期計測)

Case	P (kPa)	Actual Temp. (K)	Meas. Temp. (K)	DT (K)	στ (K)
1	33.5	295	299.4	4.4	1.4
2	33.5	295	300.9	5.9	1.5
3	34.0	294	302.5	8.5	2.8
4	34.0	294	304.0	10.0	2.6



図18 低圧での吸収量計測データ

#### 5.4 計測ソフトの改良

5.3 節に述べた大気圧環境下のレーザ光の光路上の水 分子の影響であるが、大気圧下の光学系は LD から計測 部まですべてが光ファイバで構築され、レーザが空間中 を通過する部分は存在しないため、当初は大気圧環境部 分の水分子の影響はないものと考えていた。水分子の影 響を受けるとすれば図 19 に示した光ファイバを分岐、あ るいは光量削減のために用いられるファイバ・スプリッ タの black box 部分である。この中には固体のビームスプ リッタが入っており、光ファイバから出たレーザ光が空 間を通過する微小部分が存在する。



図19 ファイバ・スプリッタ

5.3 節の結果より、大気圧下の水分子の影響を排除する ため、まず最初に、通常行われる方法である光学系全体を 覆い、窒素でパージする方法(ビニール袋で系をカバーす る方法が最も簡単であり、"Nitrogen Bag"と呼ばれていた) を用いた。しかしこの方法では効果がなかった。ファイ バ・スプリッタ中の black box はある程度密封された構造 になっており、この中に存在する水分子は高々数時間の窒 素パージでは置換できないためであろうと考えられる。

ハードウェアでの対処が難しいため、次にソフトウェ アでの対処を考えた。Voigt fitting で、計測部の低圧部分 に相当する半値幅の小さい吸収線形状と、大気圧部分に 存在する半地幅の大きい吸収線形状重ね合わせる方法で ある。

図 20 は計測部を可能な最低圧まで減圧した場合の計 測データと改良したソフトウェアを用いて fitting した 2 種類の吸収線形状の例であり、下段は計測データと fitting 形状との残差である。fitting カーブの計測部内部分 はソフトウェア上での最適値決定ルーチンによって求め られるが、大気圧成分の各係数は較正によって決定した 定数を用いる。この大気圧成分の較正としては、本来は 計測部を十分な低圧に減圧し、計測部での水分子の影響 を除去した上で大気圧成分に対して最適値決定ルーチン を適用して決定すべきであるが、計測部を含む真空タン クには多少の漏れがあり、最低圧力が図 20 の 0.5kPa ま でしか到達せず計測部内の水分子の影響を排除すること ができなかったため、大気圧成分は最低圧状態でのベー ス成分を最も良く再現する係数を手作業で決定した。

図 18 と図 20 は圧力などの条件は異なるが、両者を比較することで大気圧成分を取り入れた図 20 では計測データと良く一致する fitting を行うことができるように改良されていることが確認できる。温度算出などの基礎データとなる integrated absorbance の算出などは計測部内部分の fitting 係数のみを用いて行う。



図 20 0.5kPa での計測データと改修後のソフトウェアに よる Voigt fitting 及び残差 左: High E" Line, 右: Low E" Line

#### 5.5 静的温度検証(ソフト改良後の結果)

5.4 節で改良された計測ソフトウェアを用いて表 1 に 示したものと同じ計測データを再処理した。その結果を 表 2 に示す。上から 4 行が表 1 に対応する結果である。 表 1 では温度誤差 DT が最大で 10K であったが、表 2 で は 5.5K にまで改善された。表 1 では示さなかった 16.7kPa, 6.8kPa, 2.8kPa のケースについても改良前は 20-30K 程度 の温度誤差があったところを改良後は 2.8kPa の場合で も 4.5K の誤差に収まった。標準偏差については低圧ほど 大きな値となっているが、これは 5.1 節で述べたことと 同様に低圧ほど integrated absorbance が小さくなり計測 精度が低下するため必然的に標準偏差が大きくなる。

図 21 は(a) 33.5kPa と(b) 2.8kPa の Voigt fitting の例であ る。両者ともに計測データと fitting 結果との間の残差は ほぼ 0 であり、2.8kPa のケースでも fitting が十分に機能 していることが確認できる。





(a)

図 21 計測データと改良ソフトによる fitting 結果 (a) 33.5kPa, (b) 2.8kPa

左: High E" Line, 右: Low E" Line、各画像の上段は吸収 量の計測値と Voigt fitting 結果、下段は計測値と fitting 結 果との残差を示す

Case	P (kPa)	Actual Temp. (K)	Meas. Temp. (K)	DT (K)	στ (K)
1	33.5	295	296.0	1.0	2.0
2	33.5	295	293.9	-1.1	2.2
3	34.0	294	299.4	5.4	4.3
4	34.0	294	299.5	5.5	4.1
5	16.7	295	297.9	2.9	2.3
6	6.8	295	297.6	2.6	3.6
7	2.8	295	299.5	4.5	7.3

	表 2	静的温度検証結果	(改良後)
--	-----	----------	-------

#### 5.6 Expansion Tube 試験

構築してきたシステムを expansion tube に適用し気流 静温を計測する試験を行った。expansion tube で通常用い られる高圧管気体=He,低圧管気体=空気,膨張波管気体 =Heのケースと、通常用いられるケースではないが比較 対象としての高圧管気体=He,低圧管気体=空気,膨張波 管気体=空気のケースの2つに対して気流静温測定を行 った。

以下にこれら2つのケースについての測定例を記す。

#### 5.6.1 膨張波管気体が He の場合

高圧管 607kPa (He), 低圧管 93.3kPa (wet air), 膨張波管 2.7kPa(He)のケースの試験結果を図 22 に示す。同時に計 測された衝撃波マッハ数の計測結果から推定された試験 気体の気流条件は Ts=240K, Ps=35kPa, M=3.0、膨張波管 気体部分で Ts=510K, M=1.7 である。膨張波管気体部分で は推定されたマッハ数が M=1.7 であるため 22.5° との楔 の角度から、試験模型の矩形チャネル内で流れがチョー クしている可能性が高く、定量的な温度評価には用いる ことができない。

図 22(a)は処理結果の生データであり、赤線が計算され た温度、黒線が模型内に設置されたピトー圧プローブの 履歴である。0~5.5msの間は計測部には初期の膨張波管 気体である He とリークした水分を含む空気、あるいは これが入射衝撃波によって加熱されたものが存在するが、 含まれる水の分圧が小さいために吸収量も小さく、結果 として算出される温度も誤差の大きいものとなっている。 5.5ms 以降は試験気体である wet air が到達するため吸収 量が大きくなり、算出温度のばらつきも小さくなってい る。(a)では 0~5.5ms の温度のばらつきが大きく、ばら つきに隠れて現象の議論が難しいために(a)に5点を用い た移動平均を加えた結果を(b)に示す。また(c)は計測され た integrated absorbance の履歴である。

試験気体部分については、図 22(c)の integrated absorbanceの履歴より試験時間は5.5-6.8ms 程度でありこ の区間では圧力もそれほどの大きな変動はないといえる レベルである。この試験時間の温度は 260K 程度から 280K 程度まで徐々に変化している。この温度は衝撃波マ ッハ数から推定した気流静温 Ts=240K よりやや大きい値 であるが、システムの温度計測誤差(図 15(c))が 7-8K あること、推算に用いた衝撃波マッハ数は膨張波管の管 端から 1.5m の部分で計測した値であり、衝撃波マッハ 数は expansion tube の流れ方向に徐々に減速するため試 験気体である低圧管気体を通過した衝撃波マッハ数は測 定値より大きいことが予想されること、などを考えると 妥当な差であると考えられる。





図 22 気流静温及び integrated absorbance 計測結果 初期設定圧力:高圧管 607kPa (He),低圧管 93.3kPa (wet air),膨張波管 2.7kPa (He),(a) 静温及びピトー圧,(b) 静温 及びピトー圧で(a)の静温データに5点移動平均を掛けた もの,(c) integrated absorbance

#### 5.6.2 膨張波管気体が空気の場合

高圧管 607kPa (He),低圧管 93.3kPa (wet air),膨張波管 2.7kPa(wet air)のケースの試験結果を図 23 に示す。同時 に計測された衝撃波速度の計測結果から推定された試験 気体の気流条件は Ts=230K, Ps=33kPa, M=2.76、膨張波管 気体の推定気流条件は Ts=870K, M=1.4 である。このケー スでも膨張波管気体部分では推定されたマッハ数が M=1.4 であるため試験模型の矩形チャネル内で流れがチ ョークしている可能性が高く、定量的な温度評価には用 いることができない。

図 23(a)はピトー圧と算出された静温であり、赤線・ピ ンク線が計算された温度、黒線が模型内に設置されたピ トー圧プローブの履歴である。(b)は計測された integrated absorbance の履歴である。(b)の integrated absorbance の履 歴からは、膨張波管気体が終わり試験気体である低圧管 気体が到達するのが 2.4ms 付近であり、そこから 2.8ms 付近までの 0.4ms 程度が接触面に相当する混合領域であ る。(a)の温度履歴についても 2.4ms から 2.8ms にかけて 勾配をもって温度が低下しているのは接触面が幅をもっ ていることに対応する。その後(b)での 2.8~3.0ms の integrated absorbance のプラトー部分が試験時間に相当す る。この部分の温度は 320K から 300K に多少低下してい るが試験に用いるに十分に安定しているといえるレベル である。この温度は衝撃波マッハ数からの推算 Ts=230K とは大きな差がある。ピトー圧履歴を観察すると、図23 では図 22 のピトー圧履歴に比較して 2.5ms から 3ms に かけての領域でのステップ的な圧力上昇が鈍い。断定は できないが、この鈍い圧力上昇は膨張波の入射によるも のであると思われる。衝撃波マッハ数を計測する圧力ポ ートの下流で膨張波が低圧管気体に追いつき、流れの状 態量を理想状態から変えてしまったために前述のような 推算温度と計測温度の差が生じたのであろうと考える。 この時点での expansion tube の管の配置は 5.6.1 に記した 膨張波管気体が He の場合の配置を使っており、膨張波 管気体だけを空気に交換した状態で試験を行った。この ため試験気体の時間領域に膨張波が入射する可能性は十 分考えうる。







図 23 気流静温及び integrated absorbance 計測結果 初期設定圧:高圧管 607kPa(He),低圧管 93.3kPa (wet air), 膨張波管 2.7kPa (wet air) (a) 静温及びピトー圧, (b) integrated absorbance

#### 6. まとめ

半導体レーザ吸収法による Stanford 6 inch Expansion Tube 気流の静温測定を行った。最適な吸収線を選定する line selection program の作成から始め、試験模型及び計測 光学系設計、計測システムの構築、LabVIEW 上でのデー タ処理プログラムの構築などのシステム整備を行い、整 備したシステムを用いて最初に LD1 台による expansion tube の試験時間同定試験を行い、ピトー管データだけか らでは確定できない風洞試験時間の同定を行った。次に 静的な既知温度場を用いた温度検証を経て expansion tube の飛行試験用条件の静温計測試験を行い、膨張波管 気体が He の場合と空気の場合の両者に対して試験時間 中の静温の時間履歴計測を行った。

半導体レーザ吸収法は温度や数密度だけでなく、質量 流量や特定の化学種の存在率などのさまざまな状態量を

高速かつ非接触に計測できる技術である。現時点での世 界的な流れの主流は、半導体レーザ吸収法を燃焼場で用 いる方向であるが、そのリアルタイム性を活かしたフィ ードバック技術としてや、高速で空間状態量を計測でき ることなどから空力や制御の面でも広いポテンシャルを 持っている。本技術は将来にわたって航空宇宙機の研究 開発において有効に活用することができる技術であるこ とは間違いなく、今後の研究開発の場に活かしていきた い。

#### 参考文献

- L. C. Philippe and R. K. Hanson, "Tunable Diode Laser Absorption Sensor for Temperature and Velocity Measurements of O<sub>2</sub> in Air Flows," AIAA 91-0360
- [2] M. G. Allen and W. J. Kessler, "Simultaneous Water Vapor Concentration and Temperature Measurements Using  $1.31-\mu$  m Diode Lasers," AIAA J. Vol.34, No.3, 1996. pp. 483-488.
- [3] P. L. Varghese, C. S. Miller and R. Villarreal, "Temperature and CO2 Concentration Profiles in Flames Measured by Laser Absorption Tomography," AIAA 97-0317, 1997.
- [4] http://navier.stanford.edu/thermosciences/theses.html Recent Theses in the Thermosciences Group of the Mechanical Engineering Department の中で Advisor="Hanson"となっている諸研究
- [5] K. Lyle, "Development of a Real-Time Diodelaser Mass Flux Sensor for Simultaneous Measurement of Density and Velocity of Oxygen," Stanford PhD. Thesis, TSD report 163, 2005.
- [6] D. W. Mattison, et al, "Tunable Diode-Laser Temperature Sensor for Evaluation of a Valveless Pulse Detonation Engine," AIAA-2005-0224, 2005.
- [7] A. Mohamed, et al., "Tunable Diode Laser Measurements on Nitric Oxide in a Hypersonic Wind Tunnel," AIAA J. Vol.34, No.3, 1996, pp. 494-499.
- [8] S. D. Wehe, D. S. Baer and R. K. Hanson, "Tunable Diode-Laser Absorption Measurements of Temperature, Velocity, and H2O in Hypervelocity Flows," AIAA 97-3267, 1997.
- [9] 中北、山崎、出口、穂積、"衝撃風洞澱点温度直接計 測の試み、"宇宙航行の力学シンポジウム、1998、pp. 113-116.
- [10] M. Matsui et al., "Laser diagnostics of atomic oxygen in arc-heater plumes," AIAA-2002-793, 2002.
- [11] G. B. Rieker, et al, "Rapid Measurements of Temperature and H2O Concentrations in IC Engines with a Spark

Plug-Mounted Diode Laser Sensor," 31st Int. Symp. on Combustion, Heidelberg, Aug. 2006; in Proc. Comb. Inst 31, 2007, pp.3041-3049.

- [12] R. G. Morgan, "Development of X3, a Superorbital Expansion Tube," AIAA-2000-558, 2000.
- [13] W. N. Heltsley et al., "Design and Characterization of the Stanford 6 Inch Expansion Tube," AIAA 2006-4443, 2006.
- [14] E. E. Whiting, "An Empirical Approximation to the Voigt Profile," J. of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol. 8, Issue 6, 1968, pp. 1379-1384.
- [15] L. S. Rothman et al., "The HITRAN 2004 molecular spectroscopic database," J. Quant. Spectrosc. Radiat.Transfer, Volume 96, Issue 2, 2005, pp. 139-204.
- [16] http://cfa-www.harvard.edu/HITRAN/
- [17] X. Zhou, "Diode-Laser Absorption Sensors for Combustion Control," Stanford PhD. Thesis, TSD report 161, 2005.

#### Appendix

#### 高温場計測システムの検討

本文で紹介した温度の低い expansion tube 試験ケース への静温計測システムの他に、expansion tube の高温場試 験ケースへの拡張を念頭に置き、吸収線の選定とテスト スタンドを用いたシステムの確認を行ったので appendix として紹介する。

#### A-1. 使用吸収線の選定、計測ソフトの改修

計測用ソフトウェア、ハードウェアには低温計測の場合 と構成に大きな変化はないが、計測対象となる吸収線を高 温で吸収量変化の大きなラインに変更する必要がある。こ れに伴い半導体レーザも異なる波長のものに変更する。

4.1 節, 5.1 節と同様に line selection プログラムを用いて 1000-1500K の温度場を計測するための最適な line pair を 選定した。この選定に際しては、高温場の吸収線データ ベース、特に線強度のデータは誤差が大きいため、これ までに Stanford 大において較正済の吸収線データベース に記述されている吸収線に限定した。これらの特性デー タのうち、E", line center, 圧力広がりなどのデータは HITRAN 2004 から、線強度のデータは Stanford のデータ ベースから、それぞれ取り込んだ。

図 A-1 に (a), (b)に選定された吸収線を、(c)にこの line pair に noise floor 0.2%を仮定して求めた推定温度計測精 度示す。(a)は lower state energy の高い側のラインであり 中心波数 $v_0$ =7444.35 cm<sup>-1</sup> と 7444.37cm<sup>-1</sup> ( $\lambda_0$ =1343nm)の2 本のラインが近接して存在するためにあたかも1本のラ インのように扱うことのできるラインであり、lower state energy E"は 1774.8 と 1806.7 である。(b)は lower state energy の低い側のラインであり、中心波数 $v_0$ = 7185.60 cm<sup>-1</sup> ( $\lambda_0$ =1392nm)、lower state energy E"は 1045 である。

図 A-1(c)はこの line pair に noise floor 0.2%を仮定して 求めた推定温度計測精度である。図 A-1 では H2O 分圧を 1%として計算している。高温領域では低温よりはるかに 多くの量子的な準位が励起するために多数の吸収線が存 在し、各々の吸収線の吸収量=量子的な存在確率は小さ くなる。よって図 A-1(c)での計測誤差は低温での例(図 16(c))よりも1オーダー大きな値となっている。この誤 差を改善するためには半導体レーザの光路長を大きくす るためにレーザ光を数往復させる方法や、test gas 中の H<sub>2</sub>O 含有率を大きくするなどの方法が考えられる。

図 A-1(c)での他の問題点としては、高温側で計測精度 が悪くなっていることがある。これは用いたライン、特 に high E" line 側の E"の値が 1000-1500K の対象温度範囲 に対してやや小さいためである。high E" line 側ラインの E"の値として 3000 以上のものを用いる選択肢もあり、 この場合には温度計測誤差も改善するが、high E" line の 吸収量は図 A-1(a)よりはるかに小さくなる。温度精度よ りも十分な吸収量を持つ line を使う方が良い、との観点 から図 A-1(a),(b)のペアに決定した。

計測ソフトに関しても、基本的な構成は低温計測の場合 と同様であるが、吸収線の情報を交換し、high E" line, low E" Line それぞれに計測対象ライン以外に近傍の吸収線も 同時に計測されてしまうために Voigt fitting の部分でこれ らのラインも含めて fitting を行うように改良した。





#### A-2. 溶鉱炉を用いた高温場での吸収線計測

選定した吸収線と改修したソフトの検証を目的とし、 温度場が他の方法で計測可能な静的な高温場を用いてシ ステムの確認を行った。高温場の発生装置としては single-zone furnace (単一区画型溶鉱炉)を用いた。図 A-2 に single-zone furnace と半導体レーザ吸収法の計測シス テム、及び single-zone furnace の内部構成断面図を示す。 右上の断面図にあるように、furnace 内部でも端部では外 気に近いために温度分布が一様ではなくなる。温度分布 が一様な中心部のみを計測に用いるため、中心部にのみ 計測対象ガスを注入するテストセルが存在し、両端部は 石英ガラスのロッドとすることでこの部分の温度がガス に及ばないような構造となっている。furnace での試験時 には expansion tube で想定される気流圧力同じ設定圧力 とし、試験気体はビニール袋内部に容器に入れた水を置き  $H_2O$  蒸気圧を飽和させた環境から供給する。 $H_2O$  分圧 は約 2.5%、レーザ計測距離=20cm である。これは減圧タンクを用いて  $H_2O$  分圧を 10%とし、レーザ計測距離 =7.5cm である expansion tube 試験の約 2/3 の吸収量である。furnace の温度は軸方向に 4 点設置された K 熱電対を 用いて計測する。

図 A-3 に設定温度を 810K とした場合の furnace による 吸収線計測結果及び fitting curve、実験データと fitting curve との残差を示す。この結果から、high E" line, low E" line ともに下段の残差は 0.2%以下であり改修したソフト ウェアを用いた fitting ルーチンは十分に機能しているこ とが確認できる。



図 A-2 Single-zone furnace に設置された 半導体レーザ吸収法計測システム



図 A-3 Furnace による吸収線計測結果及び fitting curve、実験データと fitting curve との残差 設定温度 810K, H<sub>2</sub>O 分圧 約 2.5%, レーザ計測距離=20cm (a) High E" Line, E"=1774.8+1806.7, (b) Low E" Line, E"=1045